## Использование остросфокусированного ионного пучка для стимулирования процесса зарождения пор на поверхности при глубоком анодном травлении кремния

Е. Ю. Гаврилин ИПТМ РАН, Черноголовка, Россия

Электрохимическое формирование пористого кремния в растворе плавиковой кислоты известно уже более сорока лет. Открытие необычных оптических свойств микропористого кремния и их интерпретация в рамках квантовой теории поставило задачу получения микронных и субмикронных периодических структур фотонных кристаллов ( $\Phi$ K), разработку методов их промышленного выпуска для применения в качестве волноводов, светоизлучающих диодов, датчиков инфракрасного излучения и других элементов оптоэлектроники.

Одним из альтернативных методов получения ФК структур является способ формирования центров нуклеации пор на поверхности кремния с помощью остросфокусированного ионного пучка. Данный метод имеет целый ряд преимуществ перед стандартной фотолитографией, так как позволяет формировать элементы с прецизионной точностью, без какого бы то ни было использования дополнительных масок и связанных с этим процессов химической и термической обработок образцов.

Для экспериментов использовался кремний р-типа проводимости с удельным сопротивлением  $5-8~\rm Om\cdot cm$ , ориентация поверхности (100). Ионная обработка поверхности производилась на установке с остросфокусированным ионным пучком. Энергия однозарядных ионов галлия составляла  $25~\rm kpB$ . Диаметр ионного зонда на образце равнялся  $100~\rm hm$ , плотность тока  $\sim 1~\rm A/cm^2$ . Экспонирование структур проводилось путем перемещения пучка ионов по поверхности образца с помощью компьютерной программы PROXY. Доза экспонирования определялась временем выдержки пучка в точке. Размер экспонируемых ионным зондом участков составлял от  $100~\rm hm$  до  $2~\rm mkm$  в диаметре, а расстояние между центрами этих участков изменялось от  $0.6~\rm mkm$  до  $5~\rm mkm$ . Процесс глубокого анодного травления проводился при комнатной температуре в растворе плавиковой кислоты в диметилформамиде при плотностях тока травления от  $0.2~\rm go~10~\rm mA~cm^{-2}$ .

В работе обсуждаются полученные экспериментальные результаты и пред-

ложена технология формирования  $\Phi K$  структур с использованием процесса глубокого анодного травления кремния, стимулированного локальной обработкой поверхности остросфокусированным ионным пучком.